



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D213081 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 08 月 01 日

(21)申請案號：109306837

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 12 月 04 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-99

(30)優先權：2020/06/15 日本

2020-011848

(71)申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本

(72)設計人：城俊彥 JO, TOSHIKO (JP)；坂下訓康 SAKASHITA, KUNIYASU (JP)

(74)代理人：何愛文；王仁君

(56)參考文獻：

TW D112939

TW D133944

TW D133945

TW D174924

TW D175118

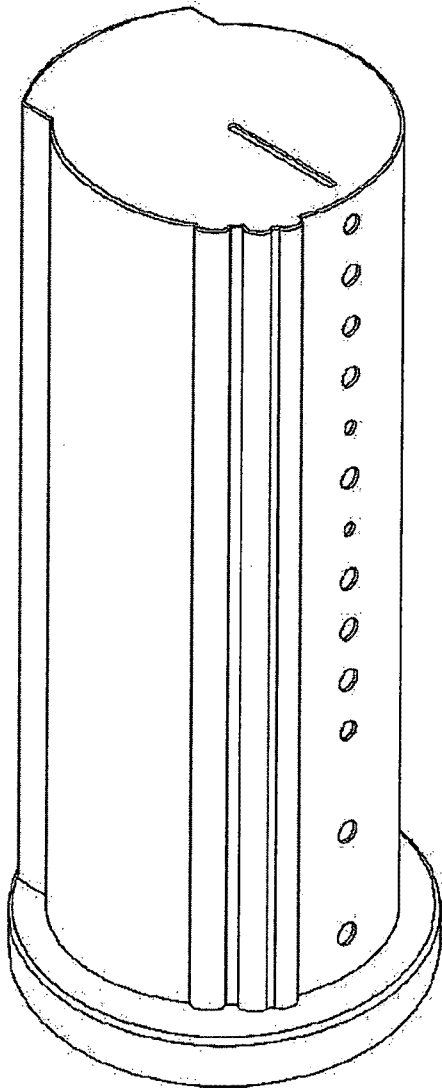
審查人員：朱哲慶

圖式數：11 共 12 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用反應管（一）

代表圖：



【立體圖】

D213081

【設計說明書】

【中文設計名稱】半導體製造裝置用反應管(一)

【物品用途】

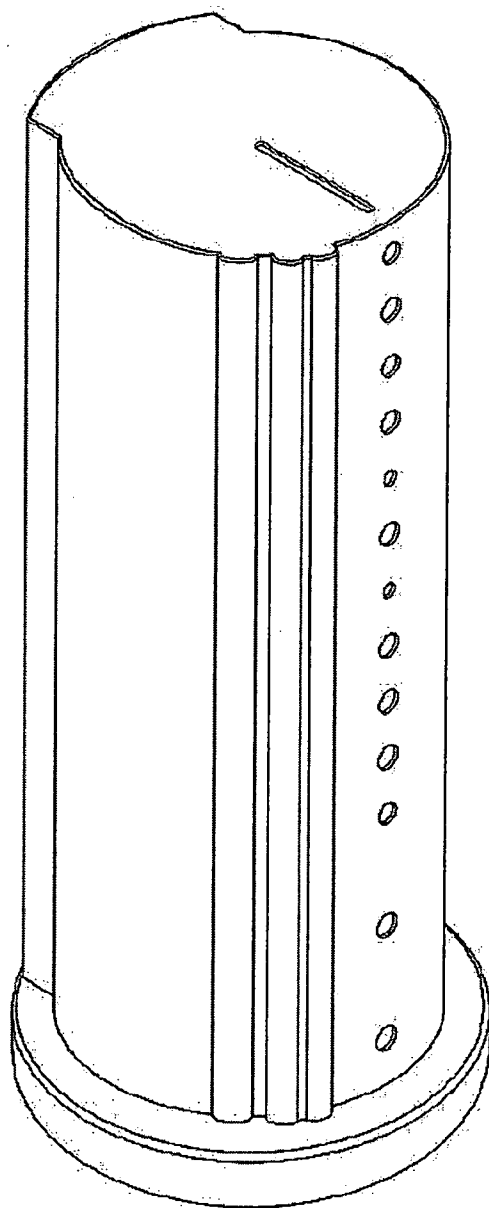
【0001】 本設計物品如表示使用狀態的參考剖面圖所示，係在半導體製造之成膜過程中設置在成膜裝置內，會使製品晶圓與氣體反應的管。具體而言，在本設計物品內積層有製品晶圓的狀態下使氣體流入，以在製品晶圓的表面成膜，但此時，必須使本設計物品內的上下部分之氣體濃度成為均勻。形成在平面部左右中央位置的寬度細之縱長橢圓形狀的孔、及在正面部左右中央位置處配置在上下方向之多個大小孔，皆為用以將流入之氣體排出的氣體通道，而具有使本設計物品內部整體氣體濃度均勻的功能。

【設計說明】

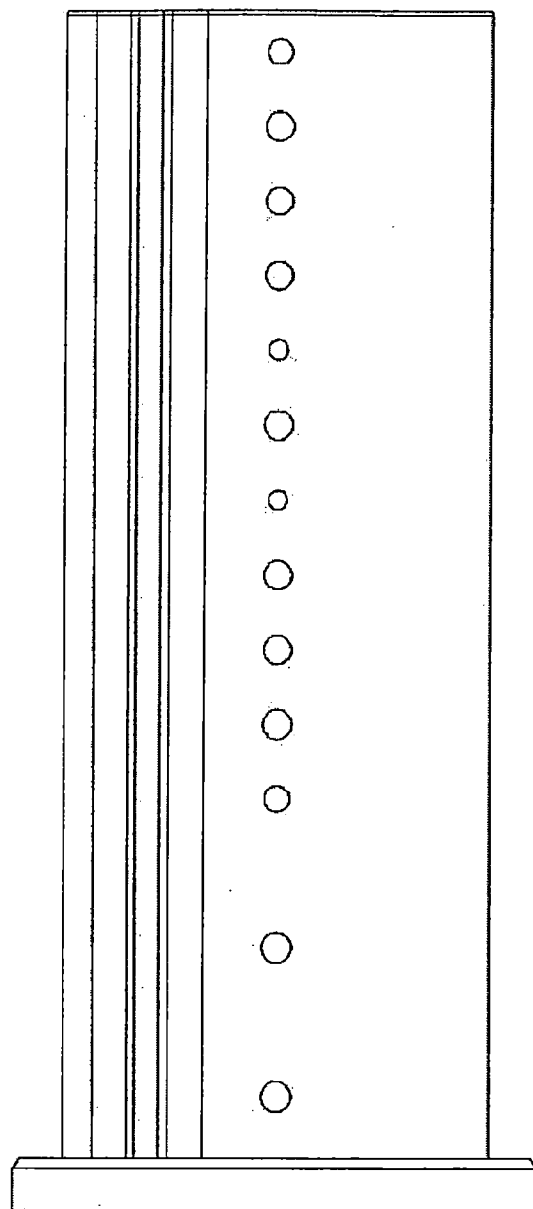
【0002】

【設計圖式】

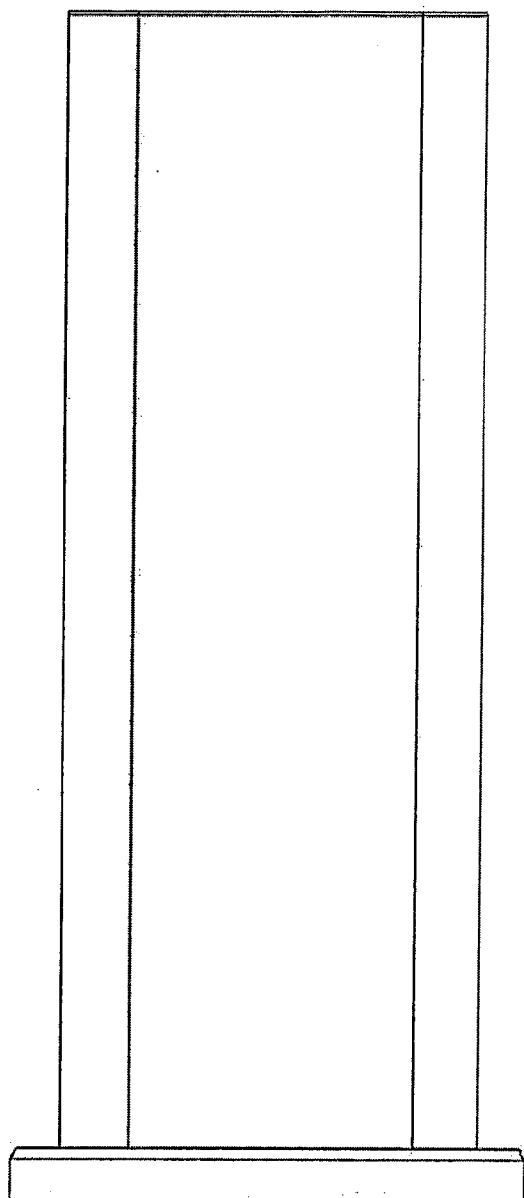
(指定代表圖)



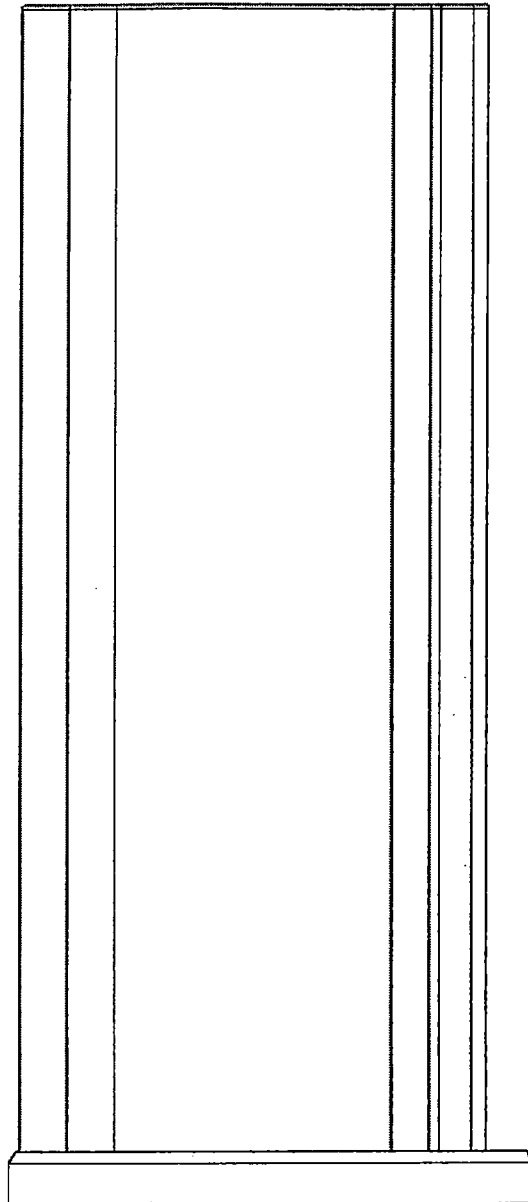
【立體圖】



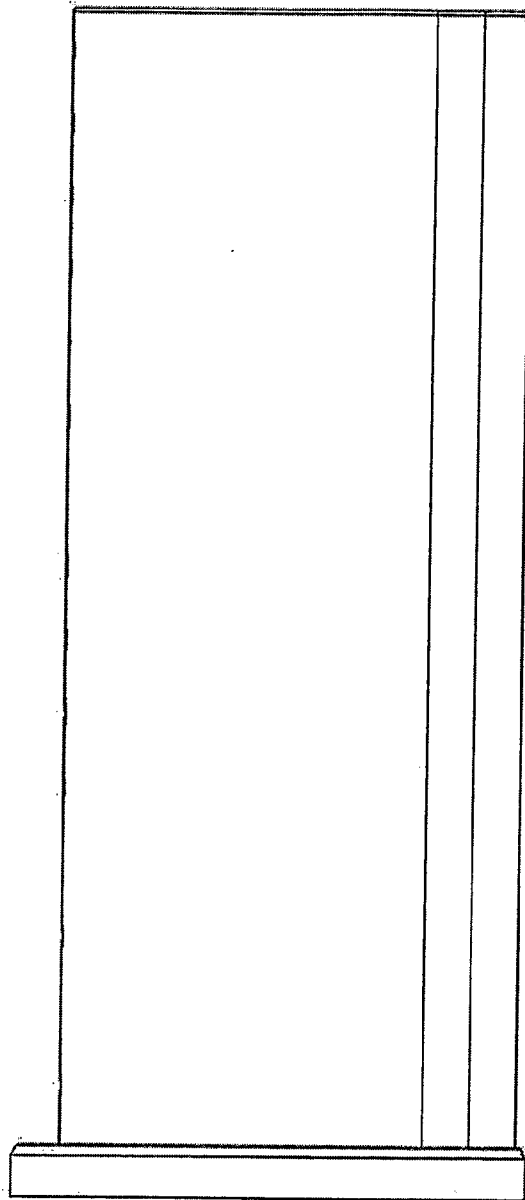
【前視圖】



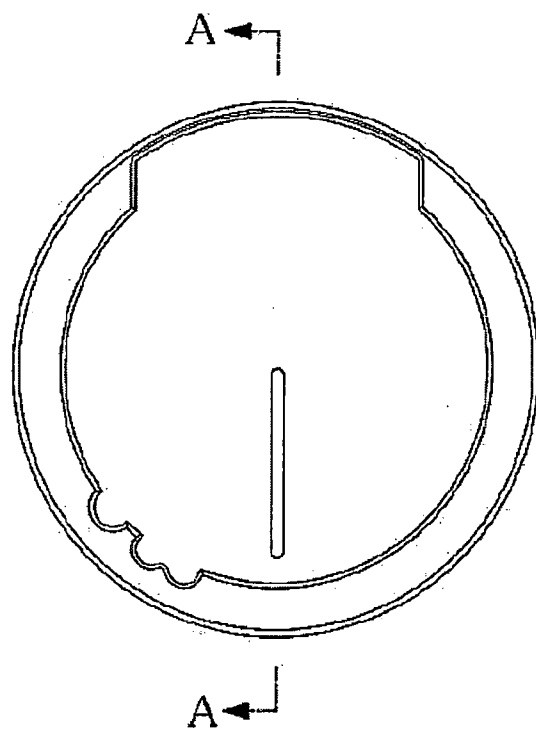
【後視圖】



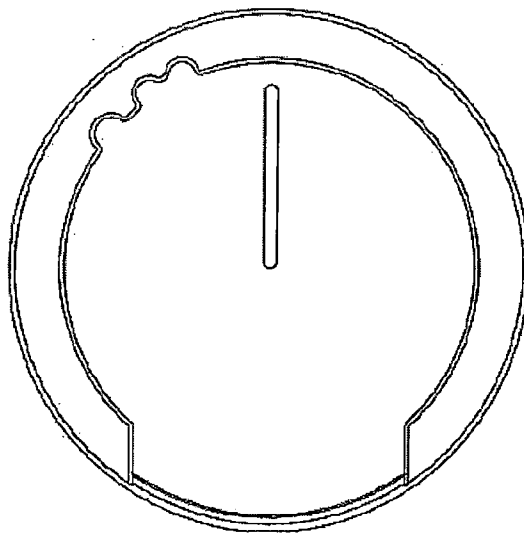
【左側視圖】



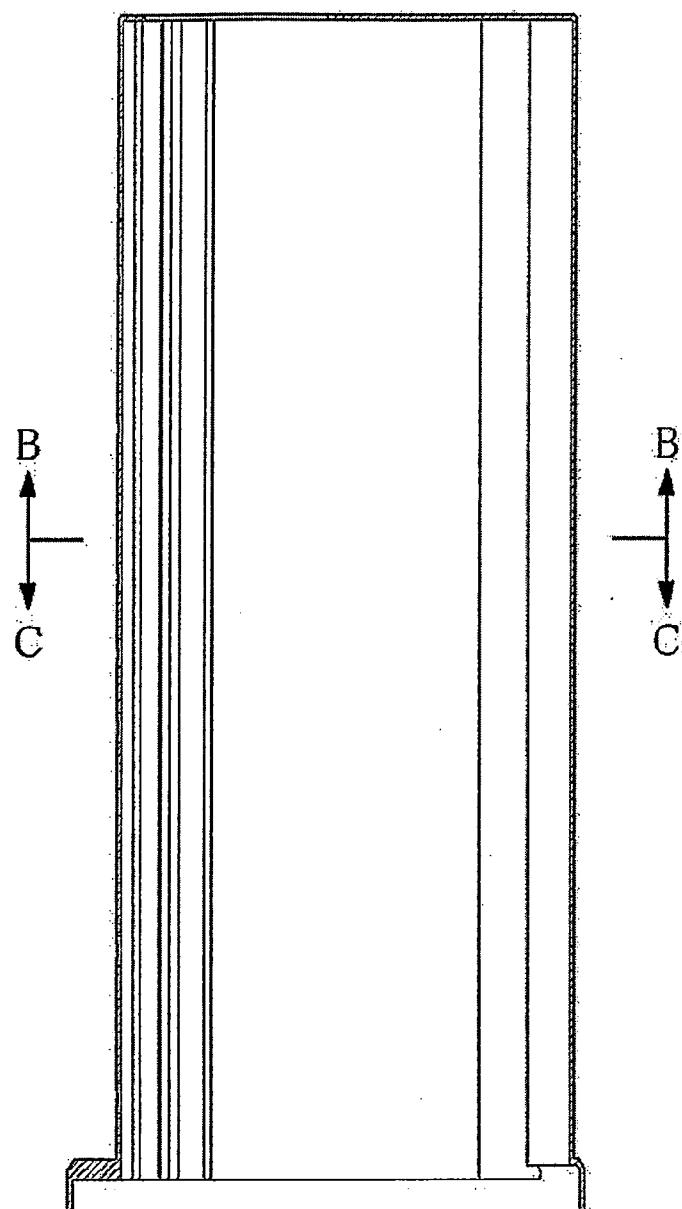
【右側視圖】



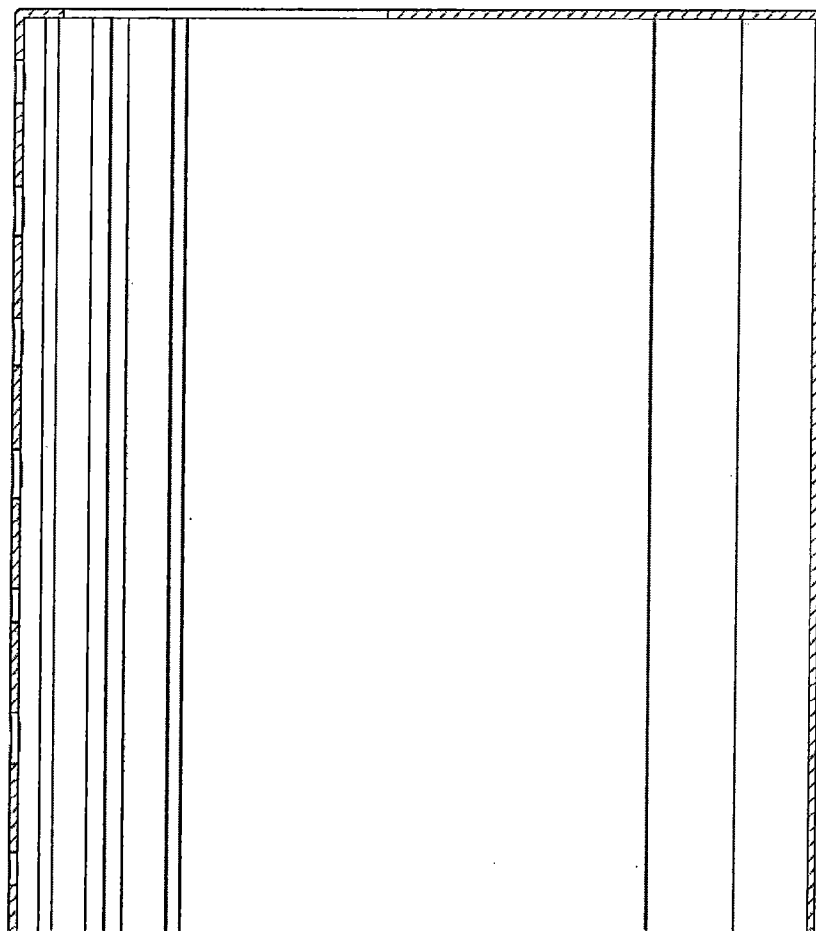
【俯視圖】



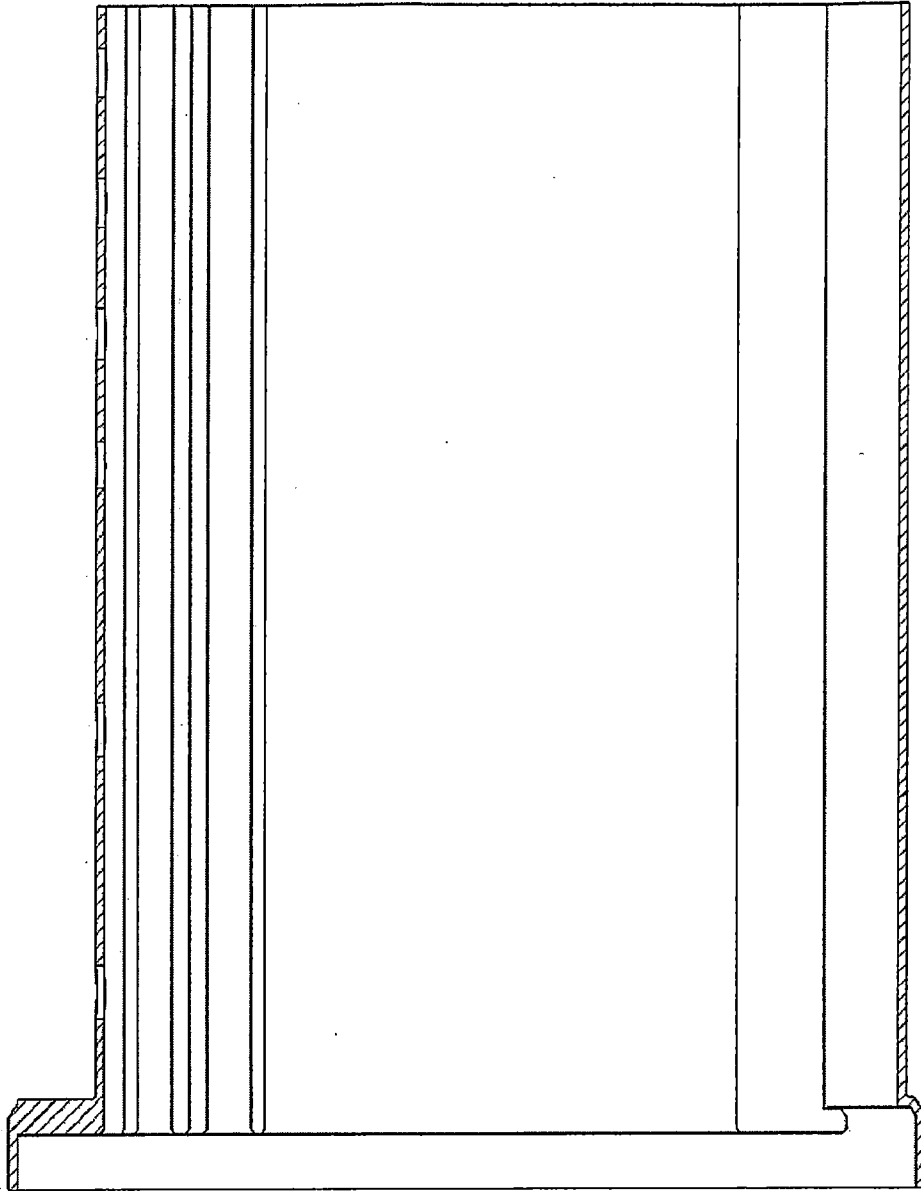
【仰視圖】



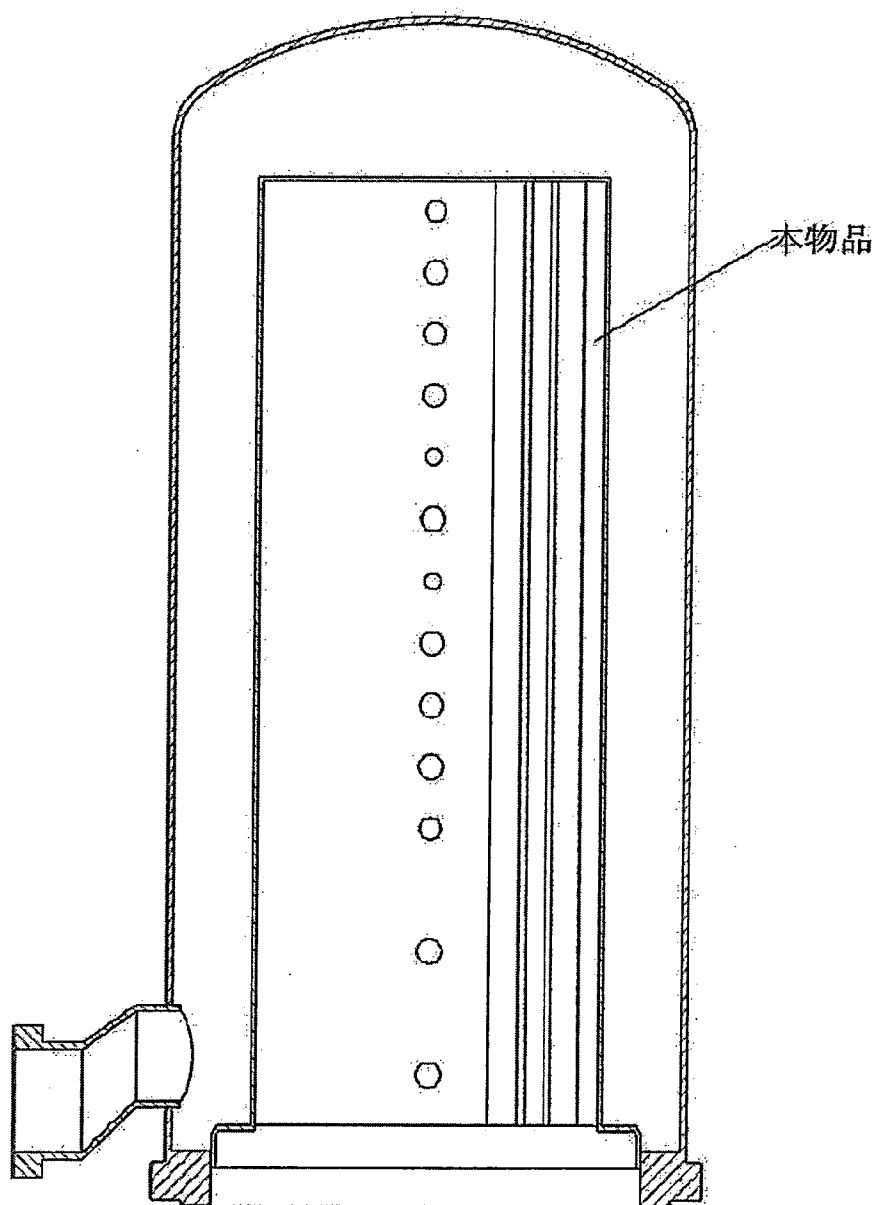
【A-A線剖面圖】



【B-B部分放大圖】



【C-C部分放大圖】



【表示使用狀態的參考剖面圖】